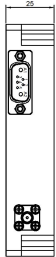


10700–12700 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W

GaNアンプは10700–12700 MHzで標準飽和出力100 W、標準利得50 dBを備えます。標準平坦度±1 dB、100 W出力時の標準高調波–50 dBcを規定しています。



電気仕様 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω 原資料は50 Wでの動的電流を標準22 Aとしていますが、ピン3の保護説明は15 A超が5 s続くと停止し、電源の再投入が必要と記載しています。試験条件と保護条件の関係は説明されていません。動的電流値とピン3の割当は掲載していません。組込み前に適用電流と保護動作を確認してください。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	10700	-	12700	MHz
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	-	50	-	dB
電力利得平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
入力リターンロス	S11	-	-	-15	dB
100 W 時の高調波	H	-	-50	-	dBc
スプリアス信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	-	VDC
静止電流	IQ	-	9	-	A
電力付加効率	Eff	-	15	-	%

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm 最大
Pout = 100 W 時の負荷 VSWR	∞; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C → 停止 (最大)

環境仕様 · 設計目標；案件ごとの確認が必要

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
動作温度	-20	-	50	°C	-
保存温度	-25	-	65	°C	保存温度
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%	-

機械仕様：原本の機械図面から抜粋した端面図です。完全な外形図や確認済みの配線図ではありません。原表ではピン4がNC、原本CADではVSWR保護と記載されています。この割り当ては保留し、配線前の確認が必要です。

項目	値	単位
外形寸法	160 × 120 × 25[6.30 × 4.72 × 0.98] mm [in] (最大) (最大)	mm [in]
質量	2.0[4.4] kg [lb] (最大) (最大)	kg [lb]
RF 入力コネクタ	SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	N-K, メス	-
DC／制御インターフェース	ハイブリッド, D-Sub 7W2, オス	-

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
A1	A1 — 電源正極	+28 VDC
A2	A2 — グラウンド	グラウンド
1	1 — イネーブル	TTLハイレベル (3.3 V)、内部プルダウン
2	2 — 温度警報	LVTTTL: 0 V → 正常; 3.3 V / T > 85 °C → 停止; T < 65 °C → 自動復帰
5	5 — グラウンド	グラウンド

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。